

## 9015m

硅 PNP 外延平面晶体管芯片(4 " )

### ■用途:

- \* 小信号放大器
- \* 高增益、低噪声音频驱动器

### ■特征:

- \*优越的  $h_{FE}$  线性
- \*低噪声
- \*与 9014m 配对
- \*集电极电流:0.1A
- \*有效管芯数(只):63650

### ■芯片示意图



### ■芯片结构

芯片尺寸	330 $\mu$ m $\times$ 330 $\mu$ m
压焊区尺寸	基 区 90 $\mu$ m $\times$ 90 $\mu$ m 发射区 90 $\mu$ m $\times$ 90 $\mu$ m
芯片厚度	200 $\pm$ 10 $\mu$ m
锯片槽宽度	44 $\mu$ m
金属层	正面:Al 1.85 $\pm$ 0.15 $\mu$ m 背面:Au 1.1 $\pm$ 0.2 $\mu$ m

### ■电特性(Ta=25 $^{\circ}$ C)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最 小	最 大	单 位
集电极--基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C = -100 \mu A, I_E = 0$	-50		V
集电极--发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C = -1mA, I_B = 0$	-45		V
发射极--基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E = -100 \mu A, I_C = 0$	-5		V
集电极--基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -45V, I_E = 0$		-200	nA
发射极--基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -4V, I_C = 0$		-200	nA
直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -1mA$	60	1000	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(SAT)}$	$I_C = -100mA, I_B = -5mA$		-0.3	V